Family list 7 family members for: JP2000113979 Derived from 5 applications.

ORGANIC EL PANEL AND ITS MANUFACTURE

Publication info: JP3031356B2 B2 - 2000-04-10 JP2000113979 A - 2000-04-21

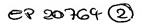
2 ORGANIC EL PANEL AND METHOD FOR FABRICATING THEREOF Publication info: KR2000028844 A - 2000-05-25

Organic EL panel and its manufacture 3 Publication info: TW443074 B - 2001-06-23

Organic EL panel and method for forming the same Publication info: US6514649 B1 - 2003-02-04

5 Organic EL panel and the Manufacture thereof Publication info: US6794816 B2 - 2004-09-21 US2003132703 A1 - 2003-07-17

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2000113979

PUBLICATION DATE

21-04-00

APPLICATION DATE

05-10-98

APPLICATION NUMBER

10282666

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR: SAKAGUCHI YOSHIKAZU;

INT.CL.

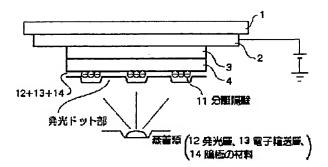
: H05B 33/10 H05B 33/12 H05B 33/14

H05B 33/28

TITLE

ORGANIC EL PANEL AND ITS

MANUFACTURE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of an organic thin film EL panel giving little damage to the picture elements of the organic EL panel and capable of being made fine and colored by a simple method.

SOLUTION: An organic luminescent material is laminated between a pair of opposite electrodes at least one of which is transparent or translucent in this manufacturing method of an organic EL panel. A photoreceptor having a charge generation layer 3 and a charge transportation layer 4 is formed on the transparent electrode 2 side, and the photoreceptor is electrified and exposed to form an electrostatic latent image. An exposure section or a nonexposure section is developed with a powder developer, and separating barrier ribs made of the electrified powder developer are formed. A luminescence layer, an electron transportation layer 13 and a cathode are uniformly deposited by a vacuum deposition method, the developer used for the separating barrier ribs is removed by transfer after deposition, a layered product of the luminescence layer, an electron transportation layer 13 and a cathode is selectively removed together, and picture element formation is made after luminescence pattern formation and cathode separation.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-113979

(P2000-113979A)

(43)公開日 平成12年4月21日(2000.4.21)

(51) Int. Cl. 7		識別記号	ΡΙ				テーマコート・		
H05	B 33/10		H05B	33/10			3K007		
	33/12			33/12		В			
	33/14			33/14		A			
	33/28			33/28					
				審査請求	有	請求項の数10	OL	(全16頁)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

(21)出願番号

特願平10-282666

(22)出願日

平成10年10月5日(1998.10.5)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 坂口 嘉一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100092277

弁理士 越場 隆

Fターム(参考) 3K007 AB14 AB15 AB18 BA06 CA01

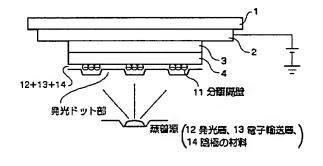
CB01 DA01 DB03 EB00 FA01

(54) 【発明の名称】有機ELパネル及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】有機ELパネルの微細化、カラー化には、メタルマスクプレートをもちいて、スライドさせる方法等がある。しかし、マスクの自重、熱膨張による歪みが生じる、マスクの位置精度、蒸着の回り込みによる分離不足が発生する等の問題がある。

【解決手段】少なくとも一方が透明または半透明の対向する一対の電極間に有機発光材料を積層した有機ELパネルの製造方法において、透明電極2側に電荷発生層3、電荷移動層4を有する感光体を形成し、その感光体を帯電、露光し静電潜像を形成する。その露光部または非露光部を、粉体現像剤を用いて現像を行い、帯電した粉体現像剤からなる分離隔壁を形成する。次いで、真空蒸着法により発光層、電子輸送層、陰極を一様蒸着し、その蒸着後、分離隔壁に用いた現像剤を転写により取り去ることにより、発光層、電子輸送層、陰極の積層体も一緒に選択的に除去して、発光パターン形成、陰極分離を行って、画案形成を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向 する一対の電極間に有機発光材料を積層した有機ELパ ネルにおいて、画素発光層と画素電極とを形成する方法 であって、

1

透明または半透明の共通電極が一方の面に形成された透 明基板を用意し、

前記共通電極上に、電荷発生層と電荷移動層とを有する 感光性薄膜を形成し、

前記感光性薄膜を一様帯電して、所与のパターンで露光 10 して静電潜像を形成し、

前記感光性薄膜の露光部または非露光部を、粉体現像剤 を用いて現像し、帯電した前記粉体現像剤からなる分離 隔壁を形成し、

発光層と電子輸送層と画素電極層とを順番に一様に堆積

堆積後、前記静電潜像の電荷を利用して、前記分離隔壁 に用いた前記粉体現像剤を転写により、その堆積体を選 択的に一緒に取り去り、

画素発光層のパターン形成と画素電極層の分離を同時に 20 行い、所望の画素パターンの画素発光層と画素電極とを 形成することを特徴とする方法。

【請求項2】少なくとも一方が透明または半透明の対向 する一対の電極間に有機発光材料を積層したカラー有機 ELパネルにおいて、画素発光層と画素電極とを各色ご とに互いに分離して形成する方法であって、

透明または半透明の共通電極が一方の面に形成された透 明基板を用意し、

前記共通電極上に、電荷発生層と電荷移動層とを有する 感光性薄膜を形成し、

前記感光性薄膜を一様帯電して、レッド、グリーン及び ブルーの3色の内の第1の色のためのパターンで露光し て静電潜像を形成し、

前記感光性薄膜の露光部または非露光部を、粉体現像剤 を用いて現像し、帯電した前記粉体現像剤からなり、前 記第1の色の画素領域以外の領域を覆う第1のマスクを 形成し、

前記第1の色の発光層と電子輸送層と画素電極層とを順 番に一様に堆積し、

堆積後、静電潜像の電荷を利用して、前記第1のマスク 40 に用いた前記粉体現像剤を転写により、その堆積体を選 択的に一緒に取り去り、前記第1の色の画素パターンの 画素発光層と画素電極とを形成し、

前記感光性薄膜を一様帯電して、レッド、グリーン及び ブルーの3色の内の第2の色のためのパターンで露光し て静電潜像を形成し、

前記感光性薄膜の露光部または非露光部を、粉体現像剤 を用いて現像し、帯電した前記粉体現像剤からなり、前 記第2の色の画素領域以外の領域を覆う第2のマスク を、前記第1のマスクの位置からずれた位置に形成し、

前記第2の色の発光層と電子輸送層と画素電極層とを順 番に一様に堆積し、

堆積後、静電潜像の電荷を利用して、前記第2のマスク に用いた前記粉体現像剤を転写により、その堆積体を選 択的に一緒に取り去り、前記第2の色の画素パターンの 画素発光層と画素電極とを形成し、

前記感光性薄膜を一様帯電して、レッド、グリーン及び ブルーの3色の内の第3の色のためのパターンで露光し て静電潜像を形成し、

前記感光性薄膜の露光部または非露光部を、粉体現像剤 を用いて現像し、帯電した前記粉体現像剤からなり、前 記第3の色の画素領域以外の領域を覆う第3のマスク を、前記第1のマスクの位置からも前記第3のマスクの 位置からもずれた位置に形成し、

前記第3の色の発光層と電子輸送層と画素電極層とを順 番に一様に堆積し、

堆積後、静電潜像の電荷を利用して、前記第3のマスク に用いた前記粉体現像剤を転写により、その堆積体を選 択的に一緒に取り去り、前記第3の色の画素パターンの 画素発光層と画素電極とを形成し、

それぞれの所望の画素パターンのレッド、グリーン及び ブルーの3色の画素発光層と画素電極とを形成すること を特徴とする方法。

【請求項3】発光層と電子輸送層と画素電極層との前記 堆積は、真空蒸着法により、発光層と電子輸送層と画素 電極層とを順番に一様に蒸着することを特徴とする請求 項1または2に記載の方法。

【請求項4】前記現像は、一定の粒径、帯電量を有する 粉体現像剤を用いて行うことを特徴とする請求項1~3 30 のいずれか1項に記載の方法。

【請求項5】前記現像剤としては、ポリエステル、スチ レン-アクリル共重合体およびアクリルから選択した高 分子に帯電制御剤を混練したものを適当な粒径まで粉砕 した粉砕現像剤、または前記高分子の重合時に帯電制御 剤を包含させて適当な粒径まで重合した重合現像剤を用 いることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記 載の方法。

【請求項6】前記感光性薄膜は、有機電荷発生層と有機 電荷移動層からなる有機感光体層であり、前記有機電荷 発生層と前記有機電荷移動層は各々、少なくとも0.0 4 μmの膜厚を有していることを特徴とする請求項1~ 5のいずれか1項に記載の方法。

【請求項7】前記有機電荷発生層は、ブチラール樹脂に 有機電荷発生剤を分散した塗液を用いて成膜し、前記有 機電荷移動層は、ポリカーボネート樹脂にホール移動性 有機化合物を分散した塗液を用いて成膜することを特徴 とする請求項6に記載の方法。

【請求項8】前記現像は、前記感光性薄膜と現像剤担持 体とを100~300μm程度離して非接触現像を行う 50 ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の

方法。

透明または半透明の共通電極が一方の面に形成された透明基板と、

前記共通電極上に形成された、電荷発生層と電荷移動層 とを有する感光性薄膜と、

前記感光性薄膜上に、画素単位に形成された、発光層と 電子輸送層と画素電極との多数の積層体とを具備してお 10 り、前記多数の積層体は、互いに分離していることを特 徴とする有機ELパネル。

【請求項10】前記多数の積層体は、レッド、グリーン 及びブルーの各色ごとに設けられ、且つ互いに分離して いることを特徴とする請求項9に記載の有機ELパネ ル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【従来の技術】特開平5-108014公報には、無機ELパネルの製造方法が開示されている。この無機ELパネルの製造方法においては、図22に示したように、同一表示カラーの画素用の発光膜部分に対応する窓パターン19Aをもつマスクプレート19を、(透明基板1上に透明電極2と絶縁層17とが積層された)パネル基板に非常に近接して配設した状態で、絶縁層17上の窓パターン19Aに対応する位置に同一表示カラーの無機発光層18を選択的にかつ一斉に蒸着源20から成膜する工程を、各色ごとにマスクプレート19の位置をずらして順次実行して、表示カラーの異なる発光膜部分を各色ごとに位置をずらして順次成膜する。以下、この方法を第1の従来方法と称する。

【0003】また、特開平7-121056には、プラズマディスプレイや液晶ディスプレイのカラーフィルタの製造方法が開示されている。この方法によれば、有機光導電層を有する感光体層を形成した基板を所望の極性に帯電し、選択的に露光して静電潜像を形成したのち、無機顔料を分散した現像剤を付着させパターンを形成し、該基板を焼成して、有機光導電層を除去して、所望のパターンを得ることができる。以下、この方法を第2の従来方法と称する。

【0004】更に、液晶ディスプレイのカラーフィルタ された透明基板を用意し、前記共通電極上に、電荷発生の製造方法としてフォトリソグラフィーを利用した顔料 層と電荷移動層とを有する感光性薄膜を形成し、前記感分散法が考えられる。これは、着色顔料を分散した感光 50 光性薄膜を一様帯電して、所与のパターンで露光して静

性ポリマーを基板に塗布した後、フォトマスクを介して 露光し、更に現像、エッチングを行って着色パターンを 形成することを、レッド、グリーン、ブルーの各色ごと と繰り返す方法である。以下、この方法を比較例の方法 と称する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記各色に応じてマスクプレートをスライドさせる第1の従来方法は、マスクプレートの自重、蒸着時の輻射熱による熱膨張でマスクプレートの撓み、歪みが発生すること、マスクプレートの微細な位置制御が難しいこと等の理由のために、各層が重なり、分離不足が発生しやすい問題があり、そのため、歩留りの観点から大画面化が困難である等の欠点がある。また、マスクプレートは薄い金属板にフォトエッチングによりパターンを開けて作成するが、微細になれば切れやすくなり、マスクプレートと基板との接触時の傷によなる。更に、マスクプレートと基板との接触時の傷による各画素のショート対策のためにマスクプレートと基板を離す必要があるが、蒸着時に蒸着材料の回り込みが発生し、微細化に限界がある。

【0006】感光体の静電潜像を無機顔料の分散現像剤で現像後、焼成して感光体を除去する第2の従来方法は、有機ELパネルには発光層や電荷輸送層等に耐熱性の無い有機材料を用いているため、有機ELパネルにはいては用いることができない。また、有機ELパネルでは、白色発光材料が現在のところ無いので、カラーフィルタを利用することは困難である。更に、顔料分散方法の場合、有機EL材料は水分に非常に弱いため、パターンニングにおいて、感光性ポリマーを基板に塗布した後、フォトマスクを介して露光し、更に現像、エッチング等のウェットプロセスを行うため、ダークスポットの発生、成長、有機層ー陰極界面剥離等で画素欠陥が発生しやすい。

【0007】以上のように、従来、現実的で効果的に微細化及び/またはカラー化が実現できる有機ELパネルの製造方法はなかった。本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであって、有機ELパネルにおいて画素にダメージが少なく、簡便な方法で微細化、カラー化が図れる有機薄膜ELパネルの製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、少なくとも一方が透明または半透明の対向する一対の電極間に有機発光材料を積層した有機ELパネルにおいて、画素発光層と画素電極とを形成する本発明による方法は、透明または半透明の共通電極が一方の面に形成された透明基板を用意し、前記共通電極上に、電荷発生層と電荷移動層とを有する感光性薄膜を形成し、前記感光性薄膜を一様帯電して、所与のパターンで露光して静

4

電潜像を形成し、前記感光性薄膜の露光部または非露光 部を、粉体現像剤を用いて現像し、帯電した前記粉体現 像剤からなる分離隔壁を形成し、発光層と電子輸送層と 画素電極層とを順番に一様に堆積し、堆積後、前記静電 潜像の電荷を利用して、前記分離隔壁に用いた前記粉体 現像剤を転写により、その堆積体を選択的に一緒に取り 去り、画素発光層のパターン形成と画素電極層の分離を 同時に行い、所望の画素パターンの画素発光層と画素電 極とを形成することを特徴とする。

【0009】また、少なくとも一方が透明または半透明 10 の対向する一対の電極間に有機発光材料を積層したカラ 一有機ELパネルにおいて、各色の画素発光層と画素電 極とを互いに分離して形成する本発明による方法は、透 明または半透明の共通電極が一方の面に形成された透明 基板を用意し、前記共通電極上に、電荷発生層と電荷移 動層とを有する感光性薄膜を形成し、前記感光性薄膜を 一様帯電して、レッド、グリーン及びプルーの3色の内 の第1の色のためのパターンで露光して静電潜像を形成 し、前記感光性薄膜の露光部または非露光部を、粉体現 像剤を用いて現像し、帯電した前記粉体現像剤からな り、前記第1の色の画素領域以外の領域を覆う第1のマ スクを形成し、前記第1の色の発光層と電子輸送層と画 素電極層とを順番に一様に堆積し、堆積後、静電潜像の 電荷を利用して、前記第1のマスクに用いた前記粉体現 像剤を転写により、その堆積体を選択的に一緒に取り去 り、前記第1の色の画素パターンの画素発光層と画素電 極とを形成し、前記感光性薄膜を一様帯電して、レッ ド、グリーン及びブルーの3色の内の第2の色のための パターンで露光して静電潜像を形成し、前記感光性薄膜 の露光部または非露光部を、粉体現像剤を用いて現像 し、帯電した前記粉体現像剤からなり、前記第2の色の 画素領域以外の領域を覆う第2のマスクを、前記第1の マスクの位置からずれた位置に形成し、前記第2の色の 発光層と電子輸送層と画素電極層とを順番に一様に堆積 し、堆積後、静電潜像の電荷を利用して、前記第2のマ スクに用いた前記粉体現像剤を転写により、その堆積体 を選択的に一緒に取り去り、前記第2の色の画素パター ンの画素発光層と画素電極とを形成し、前記感光性薄膜 を一様帯電して、レッド、グリーン及びブルーの3色の 内の第3の色のためのパターンで露光して静電潜像を形 40 成し、前記感光性薄膜の露光部または非露光部を、粉体 現像剤を用いて現像し、帯電した前記粉体現像剤からな り、前記第3の色の画素領域以外の領域を覆う第3のマ スクを、前記第1のマスクの位置からも前記第3のマス クの位置からもずれた位置に形成し、前記第3の色の発 光層と電子輸送層と画素電極層とを順番に一様に堆積 し、堆積後、静電潜像の電荷を利用して、前記第3のマ スクに用いた前記粉体現像剤を転写により、その堆積体 を選択的に一緒に取り去り、前記第3の色の画素パター ンの画素発光層と画素電極とを形成し、それぞれの所望 50 用いて成膜する。ホール移動性有機化合物には、N.

の画素パターンのレッド、グリーン及びブルーの3色の 画素発光層と画素電極とを形成することを特徴とする。 [0010]

【作用】本発明の有機ELパネルの製造方法によれば、 ガラス等透明基板に成膜した透明または半透明の共通電 極上に有機感光体を形成、帯電し、所与のパターンに選 択的に露光して静電潜像を形成したのち、発光部以外の 部分に静電潜像を形成し、前記静電潜像を、一定の粒 径、帯電量を有する粉体現像剤を用いて現像を行い、画 素の分離隔壁を形成する。また、本発明のカラー有機E レパネルの製造方法によれば、各色ごとに、透明電極側 に形成した有機感光体を帯電、露光し、当該色の発光ド ット以外の部分(すなわち、2色分のドット幅+スペー ス部分)の静電潜像を形成、現像剤を用いて現像し、現 像された部分で、密着マスクを形成する。ついで、当該 色の発光層、電子輸送層、及び画素電極層を順番に且つ 一様に例えば蒸着により形成後、分離隔壁または密着マ スクを形成している現像剤をパネル基板から除去するこ により、当該色の発光画素と画素電極を得る工程を、実 20 施する。

【0011】得られる有機ELパネルのドットピッチや スペース幅は、露光精度と現像剤粒径により決定し、大 きさが10μ程度の微細パターンが形成できる。また、 上記方法によると、前述した第1の従来方法のように基 板から離したマスクプレートを用いて真空蒸着法により 薄膜を形成した時の、マスクの浮きによる蒸着時の回り 込みがないため、色ずれ、位置ずれが発生せず、エッジ のシャープなパネルが作製できる。マスクの位置合わせ を行う必要がなく、真空プロセスを減らすことができる ため、パネル作製プロセスを高速化できる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下に、図を用いて、本発明につ いて説明する。まず、図1に示すように、ガラス等の透 明基板1上に、酸化スズインジウム (ITO)、酸化ス ズ薄膜等の透明な共通電極2を形成する。なお、共通電 極2は半透明でもよい。共通電極2を形成する薄膜形成 方法は、スパッタリング法、電子ビーム法、化学反応法 等いずれを用いても良い。透明電極2上に、有機電荷発 生層3と有機電荷移動層4からなる有機感光体層を形成 する。有機電荷発生層3には、例えばプチラール樹脂に 有機電荷発生剤を分散した塗液を用いて成膜する。有機 電荷発生剤には、無金属フタロシアニンや銅フタロシア ニンやチタニルフタロシアニンやパナジルフタロシアニ ン等のフタロシアニン化合物、ペリレン系色素、多環キ ノン系色素、スクアリリウム色素、アズレニウム色素等 が使用できる。有機電荷発生層3は、少なくとも0.0 4μmの膜厚を有していることが好ましい。

【0013】有機電荷移動層4には、例えばポリカーボ ネート樹脂にホール移動性有機化合物を分散した塗液を

N'-ジフェニル-N, N'-ジ(3-メチルフェニ ル) -1, 1'-ピフェニル-4, 4'-ジアミン(T PDと略記)、N, N'ージフェニル-N, N'ーピス ジアミン (α-NPDと略記) 等のジアミン誘導体、 4, 4', 4"-トリス(3-メチルフェニルフェニル アミノ) -トリフェニルアミンなどのアリールアミン系 誘導体、オキサジアゾールやオキサゾールやピラゾリン 等の複素環式化合物、ヒドラゾン系化合物、縮合多環式 くとも0.04μmの膜厚を有していることが好まし 61

7

【0014】電荷発生層3と電荷移動層4の薄膜形成方 法は、ディップによる方法、スピンコート法どちらを用 いてもよい。電荷発生層3と電荷移動層4からなる有機 感光体層の膜厚は、キャリアの移動度、光をガラス基板 側から取り出すことを考慮して、できるだけ薄い方が好 ましい。しかし、薄すぎるとピンホール等で絶縁破壊が 起きる。一方、有機感光体層の膜厚が厚くなると、完成 した有機ELパネルの必要な駆動電圧が高くなり過ぎる 20 ので、上限は、25μm程度が好ましい。総合的に考え て、更に好ましくは、有機感光体層の膜厚は、0.1~ 5μm程度とするのがよい。そして、電荷発生層3と電 荷移動層4との膜厚の比は、1:1から1:20が適当 である。

【0015】この後の工程は幾つかの態様をとることが できるので、態様ごとに説明する。

第1の態様

基板に形成した有機感光層を、図2に示すようにスコロ トロンワイヤ5aとグリッド5bを有するスコロトロン 30 などのコロナ帯電器5を用いて、または図3に示すよう にプラシ式帯電器やプレード式帯電器やローラ式帯電器 等の接触式帯電器6を用いて、帯電させる。透明電極2 をグラウンド電位としたときの感光体帯電電位V0は、 形成する有機膜の膜厚や移動度により変わるが、負帯電 現像剤を用い、反転現像を行うとき、-300~-12 00 V程度である。

【0016】次に、図4に示すように、反転現像の場 合、レーザーやLED等の露光器8を用いて、蒸着する 目標の発光部以外の部分を選択的に走査してパターン螺 40 光するか、蒸着する目標の発光部以外の部分を、パター ンを形成したフォトマスクを介して一様露光を行う。す なわち、形成したい画素発光層のドットパターンの反転 パターンに、帯電した感光体を露光する。このとき、透 明電極2はグラウンド電位に接続する。 露光器の波長 は、電荷発生層の吸収波長である780nm前後であ る。このとき、レーザー光等の光は、電荷発生層まで達 し、ホールー電子対を発生させ、それらホールと電子と が解離し、電子は透明電極2を介してグラウンドに逃が され、一方、ホールは、感光体表面の帯電電位VOに基

づく電界により電荷移動層に注入、移動し感光体表面ま で到達する。表面に達したホールが、帯電電荷と結合し て、帯電電荷が消滅することにより、図5に示すように 露光電位Viの静電潜像9を形成する。大きい面積の基 板に比較的粗いパターンを形成するにはフォトマスクを 用いLEDで一様露光することが効率的であり、一方、 より微細で複雑なパターンの形成にはレーザー走査鱈光 方式が有効である。

8

【0017】ついで、透明電極2をグラウンド電位に維 化合物等が使用できる。この有機電荷移動層4も、少な 10 持して、静電潜像を現像剤10で現像する。現像剤10 には、ポリエステル、スチレン-アクリル共重合体およ びアクリルから選択した高分子に帯電制御剤(CCA) を混練したものを適当な粒径まで粉砕した粉砕現像剤、 または前記高分子の重合時に帯電制御剤(CCA)を包 含させて適当な粒径まで重合した重合現像剤を用いる。 正帯電性帯電制御剤としては、ニグロシン染料や第4級 アンモニウム塩等を使用することができる。また、負帯 電性帯電制御剤としては、モノアゾ染料の金属錯体等の 電子受容性物質を使用することができる。

> 【0018】現像剤を一様帯電し且つ静電潜像を現像す るための現像器は、例えば、図21に示す構造となって いる。すなわち、図示の現像器は、現像剤10を貯留す るホッパ21と、現像剤10の帯電と静電潜像を形成し た感光層への供給とを行う現像室22とを有する。ホッ パ21内の現像剤10は、撹拌部材23によって撹拌さ れ、図では反時計方向に回転駆動するローラで構成され る現像剤供給部材24によって、図では同じく反時計方 向に回転するローラで構成される現像剤担持体25に供 給される。現像剤担持体25は、例えば、ステンレス、 アルミニウム等の金属ローラと、その外周に設けたケッ チェンプラックやアセチレンプラックで導電性を付与し たシリコーン、ニトリル・プタジエン共重合体、ウレタ ンゴム等の弾性ゴム材料からなっている。この現像剤担 持体25の表面の弾性部分は、ドクタープレードで構成 される薄層形成部材26との接触圧を考慮してゴム硬度 がJISのA硬度計で30~40度、更に、現像剤担持体の 低抵抗による静電潜像担持体へのリーク、高抵抗による 現像効率の低下、カブリ等を考慮して、最適現像効率が 得られるようにローラ表面と軸間の抵抗値が10°~1 0'Ωとなるようにする。また、後述する実施例で用い る粒径が6μm程度の現像剤を均一に帯電、搬送させる 為には、現像剤担持体の十点平均表面粗さRzは、10μm 以下であることが望ましい。

【0019】現像剤担持体25に供給された現像剤10 は、薄層形成部材26によって摩擦帯電され且つ厚さが 規制され、現像剤 1 層から数層程度の均一な薄層とな る。薄層形成部材26は、ステンレス、リン青銅等の金 **属薄板のパネ材からなる。現像剤担持体上に薄層となっ** た帯電現像剤は、現像剤担持体の回転にしたがって現像 50 剤担持体と感光体の対向部分まで運ばれ、感光体表面の

帯電電位V0、露光電位Viと現像剤担持体に印加されている現像パイアスVbとの電位差に基づく電界により、感光体表面の静電潜像に移動して像を形成する(図 5)。現像剤担持体と有機感光体は、接触していても良いし、近接した距離であれば、現像剤は電界により感光体へ飛翔するので、 $100~300\mu$ m程度離れていても良い。非接触現像を行うことで非現像部へのカブリやチリを減少させることができる。

【0020】図5に示す現像は、感光体電位と現像剤の 帯電極性が同極性の反転現像法である。画素のドットパ 10 ターンの反転パターンで露光されて形成させた図5に示 す静電潜像では、露光電位Viが反転パターンに分布 し、帯電電位 V0 (負電位) が画素のドットパターンに 分布している。そのような静電潜像を、負帯電現像剤1 0で現像すると、負帯電現像剤10は、帯電電位V0 (負電位)の画素のドットパターン部分には付着せず、 露光電位Viの反転パターン部分にのみ付着する。な お、現像プロセスとしては、図5に示すように感光体電 位と現像剤の帯電極性が同極性の反転現像法と、後述す る感光体電位と現像剤の帯電が逆極性の正現像法との2 20 つあるが、どちらを用いてよい。比較的広い領域を現像 するには正現像法が有効であり、微細領域を現像するに は反転現像が有効である。現像器を用いて静電潜像を現 像することにより、図6に示すように、発光ドットを互 いに分ける分離隔壁11が付着現像剤で形成される。

【0021】次に、図6示すように、透明電極2を正電 位にバイアスして、例えば真空蒸着法により、発光層1 2を形成する。グリーンまたはレッドの発光層12を形 成するためには、ホストにトリス(8-キノリノール) アルミニウム (アルミキノリン錯体) に代表される8-30 ヒドロキシキノリン金属錯体、1.4-ビス(2-メチ ルスチリル)ベンゼン等のジスチリルベンゼン誘導体、 ピススチリルアントラセン誘導体、クマリン誘導体、ペ リレン誘導体等を使用して、グリーンまたはレッドのた めのドーパントを共蒸着する。グリーンのドーパントと しては、キナクリドン、2、9-ジメチルキナクリドン 等キナクリドン誘導体、または3-(2-ベンゾチアゾ リル) - 7 - ジエチルアミノクマリン(クマリン54 0) 等のクマリン誘導体を使用する。レッドのドーパン トとしては、4-ジシアノメチレン-2-メチル-6- 40 (p-ジメチルアミノスチリル)-4H-ピラン(DC Mと略記)、4-ジシアノメチレン-2-メチル-6-[2-(9-ユロリジル)エテニル]-4H-チオピラ ン等のジシアノメチレンピラン色素、フェノキサゾン誘 導体、またはスクアリリウム色素を使用する。ブルーの 発光層12は、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペ ンタフェニルシクロペンタジエン、テトラフェニルプタ ジエン誘導体、ペリレン誘導体、ジベンゾナフタセン、 ベンゾピレン等を蒸着して形成する。

【0022】次に、トリス(8-キノリノール)アルミ 50 素のドットパターンの反転パターンに対応する。

ニウム、ビス(8-キノリノール)マグネシウム等の8-ヒドロキシキノリン金属錯体、オキサジアゾール誘導体、ベリレン誘導体等の、電子をキャリアとする材料を蒸着して電子輸送層13を形成する。最後に、Mg:AgやAl:Liを、それらの合金からまたは共蒸着法を用いて、真空蒸着を行い画素電極層すなわち陰極14を形成する。かくして、付着現像剤の分離隔壁11上と露出感光体表面上とに一様に、発光層12と電子輸送層13と画素電極層すなわち陰極14とからなる3層膜(12+13+14)が形成される。

10

【0023】蒸着後、図7に示すように、透明電極2を 負電位にバイアスして、発光部の分離壁に用いた現像剤 を、パネル基板から転写することにより取り去り、発光 パターン形成、陰極分離を行い、画素形成を行う。現像 剤を除去する方法としては、蒸着後基板上に厚さ10μ m程度のポリエチレン等の高分子シートまたは無塵紙等 の転写媒体15を配置し、転写媒体15の背面からコロナ帯電器(スコロトロンなど)や接触式帯電器(転写ローラなど)の転写部材16により正電界を印加して、分 離壁に用いた現像剤を転写媒体15に転写して取り去 る。このとき、3層膜(12+13+14)も選択的 に、現像剤と一緒に除去され、3層膜(12+13+1 4)がパターニングされる。

【0024】かくして、図8に示すように、発光部のパターンの形成、陰極分離を行い、モノカラーの有機ELパネルが完成する。すなわち、電荷移動層14の上に、発光層12、電子輸送層13及び画素電極すなわち陰極14とから3層積層体が、互いに分離されて形成される。そして、有機ELパネルとしては、電荷発生層3が正孔注入層として機能し、電荷移動層4が正孔輸送層として機能する。

【0025】第2の態様

以上の第1の実施の態様では、反転現像を行ったが、上述したように、正現像を行うこともできる。以下、正現像の例を説明する。有機感光層を帯電するまでの工程は、第1の実施の態様と同一である。しかし、正帯電現像剤を用いて正現像を行うときも、感光体帯電電位V0は、形成する有機膜の膜厚や移動度により変わるが、-100~-1000V程度である。

【0026】図4に示す露光工程において、正現像の場合、レーザーやLED等の露光器8を用いて、蒸着する目標の発光部を選択的に走査してパターン露光するか、蒸着する目標の発光部を、パターンを形成したフォトマスクを介して一様露光を行う。すなわち、形成したい画素発光層のドットパターンに、帯電した感光体を露光する。露光器の波長は、第1の実施の態様と同様に、電荷発生層の吸収波長である780nm前後である。この場合、露光電位Viの分布パターンは、画素のドットパターンに対応し、帯電電位V0部分の分布パターンは、画素のドットパターンの反転パターンに対応する。

12

【0027】現像は、第1の実施の態様と同様に、図2 1に示すような現像器を使用して現像する。しかし、こ の場合、現像剤10は、正に帯電している。正帯電現像 剤を用いた正現像プロセスにおいても、現像剤担持体上 に薄層となった帯電現像剤は、現像剤担持体の回転にし たがって現像剤担持体と感光体の対向部分まで運ばれ、 感光体表面の帯電電位V0、露光電位Viと現像剤担持体 に印加されている現像パイアスVbとの電位差に基づく 電界により、感光体表面の静電潜像に移動して像を形成 する(図9)。この場合、静電潜像を、正電現像剤10 10 で現像すると、正電現像剤10は、帯電電位V0(負電 位)の画素のドットパターンの反転パターン部分に付着 し、露光電位Viの画素のドットパターンには付着しな 61.

【0028】この場合も、第1の実施の態様と同様に、 現像剤担持体と有機感光体は、接触していても良いし、 近接した距離であれば、現像剤は電界により感光体へ飛 翔するので、100~300μm程度離れていても良 い。非接触現像を行うことで非現像部へのカプリやチリ を減少させることができる。

【0029】図9に示す現像は、感光体電位と現像剤の 帯電極性が逆極性の正現像法である。画素のドットパタ ーンで露光されて形成させた図9に示す静電潜像では、 露光電位 Viが画素のドットパターンに分布し、帯電電 位 VO (負電位) が画素のドットパターンの反転パター ンに分布している。そのような静電潜像を、透明電極2 をグラウンド電位にバイアスして、正帯電現像剤10で 現像すると、正帯電現像剤10は、帯電電位V0(負電 位)の反転パターン部分に付着し、露光電位Viの画素 のドットパターンには付着しない。

【0030】次に、図10示すように、透明電極2を負 電位にバイアスして、例えば真空蒸着法により、発光層 12、電子輸送層13及び画素電極すなわち陰極14と から3層積層体を形成する。発光層12、電子輸送層1 3及び画素電極すなわち陰極14とから3層積層体を形 成する工程は、第1の実施の態様と同様であるので、説 明は省略する。蒸着後、図11に示すように、発光部の 分離壁に用いた現像剤を、パネル基板から転写すること により取り去り、発光パターン形成、陰極分離を行い、 画案形成を行う。現像剤を除去する方法としては、透明 40 電極2を正電位にバイアスして、蒸着後基板上に厚さ1 0 μm程度のポリエチレン等の高分子シートまたは無塵 紙等の転写媒体15を配置し、転写媒体15の背面から スコロトロン5のようなコロナ帯電器や接触式帯電器 (転写ローラなど)の転写部材により負電界を印加し て、分離壁に用いた現像剤を転写媒体15に転写して取 り去る。このとき、3層積層膜(12+13+14)も 選択的に、現像剤と一緒に除去され、3層積層膜(12 +13+14) がパターニングされる。

【0031】かくして、図8に示すように、発光部のパ 50 グリーンのドッドパターンの反転パターンに対応するこ

ターンの形成、陰極分離を行い、モノカラーの有機EL パネルが完成する。すなわち、電荷移動層14の上に、 発光層12、電子輸送層13及び画素電極すなわち陰極 14とから3層積層体が、互いに分離されて形成され

【0032】有機ELパネルのカラー化方法、すなわ ち、カラー有機ELパネルの製造方法は、上述したモノ カラーの有機ELパネルの製造方法を、レッド、グリー ン、ブルー3色の各色ごとに実行する。従って、以下の 説明において、各色ごとに実行する工程の詳細は、上述 したモノカラーの有機ELパネルの製造方法と基本的に 同一であるので、各工程の詳細な説明は省略する。一 方、カラー有機ELパネルの製造方法は、モノカラーの 有機ELパネルの製造方法と同様に、感光体電位と現像 剤の帯電極性が同極性の反転現像法と、感光体電位と現 像剤の帯電極性が逆極性の正現像法との2つの態様で実 施できるので、各態様を以下に説明する。

【0033】第3の態様

感光体電位と現像剤の帯電極性が同極性の反転現像法を 20 使用したカラー有機ELパネルの製造方法は、以下の通 りである。上述したモノカラーの有機ELパネルの製造 方法の第1の態様により、レッド、グリーン、ブルー3 色中の第1の色、例えば、レッドの発光層12、電子輸 送層13及び画素電極すなわち陰極14とから3層積層 体を、電荷移動層4の上に形成した状態を、図12に示 す。前述の第1の態様と異なる点は、反転現像の場合、 所望のレッドの発光ドット以外の部分を露光して静電潜 像を形成する際、そのレッドの発光ドット以外の部分 は、〔他2色分(すなわち、グリーン、ブルー)のドッ ト幅〕+〔各色を互い分離するスペース部〕に相当す る。従って、そのような静電潜像を感光体と同じ帯電極 性現像剤を用いて現像して、分離隔壁を作成する。この 分離隔壁は、レッドの発光ドット以外の部分、すなわ ち、〔他2色分のドット幅〕+〔各色を互い分離するス ペース部〕に相当する領域を覆っているので、カラー有 機ELパネルの製造方法の場合、密着マスクと称する。 【0034】図12において、透明電極2をグラウンド 電位にパイアスし、更に好ましくは電荷移動層4を介し てレッドの陰極14をグラウンドにパイアスして、レッ ドの発光層12、電子輸送層13及び画素電極すなわち 陰極14とから3層積層体を電荷移動層4の上に形成し た感光性薄膜を負電荷で一様帯電して、レッド、グリー ン及びブルーの3色の内の第2の色、例えば、グリーン のドッドパターンの反転パターンで露光して静電潜像を 形成する。なお、図面において図面の簡略化のために、 発光層12と電子輸送層13とを1つの有機層として描 いている。また、電荷移動層4を介してレッドの陰極1 4をグラウンドにパイアスした場合、レッドの陰極14 上には負電荷は帯電しないが、形成される静電潜像が、

とには変わりがない。

【0035】次いで、図12に示すように、透明電極2 をグラウンド電位にバイアスし、一様帯電時に電荷移動 層4を介してレッドの陰極14をグラウンドにバイアス した場合には、電荷移動層4を介してレッドの陰極14 を正電位にパイアスして、感光性薄膜の露光部を、負電 荷で帯電された粉体現像剤を用いて現像する。その結 果、図13に示すように、粉体現像剤からなる分離隔壁 すなわち第2の密着マスク11を形成する。この第2の 密着マスク11は、負電荷に帯電した粉体現像剤からな 10 り、グリーンの発光ドット以外の部分、すなわち、 [他 2色分のドット幅〕+〔各色を互い分離するスペース 部〕に相当する領域を覆っている。従って、第2の密着 マスク11は、レッドの発光層12、電子輸送層13及 び画素電極すなわち陰極14とから3層積層体上を覆っ ており、且つ、レッドの発光層を形成するために使用し た密着マスク (第1の密着マスクと称する) の位置から ずれた位置に形成されている。

【0036】その後、図13に示すように、透明電極2 を正電位にパイアスして、グリーンの発光層と電子輸送 20 層と画素電極層とを順番に一様に真空蒸着法により蒸着 する。蒸着後、静電潜像の電荷を利用して、第2の密着 マスクに用いた粉体現像剤を転写により取り去り、グリ ーンの画素パターンの画素発光層と画素電極とを形成す る。この状態で、図14に示すように、レッドの発光層 と電子輸送層と画素電極の3層積層体と、グリーンの発 光層と電子輸送層と画素電極の3層積層体とが電荷移動 層4の上に形成されている。

【0037】図14において、透明電極2をグラウンド 電位にパイアスし、更に好ましくは電荷移動層4を介し 30 てレッドとグリーンの陰極14をグラウンドにバイアス して、レッドの発光層と電子輸送層と画素電極の3層積 層体とグリーンの発光層と電子輸送層と画素電極の3層 積層体とが電荷移動層4の上に形成されている感光性薄 膜を一様帯電して、レッド、グリーン及びブルーの3色 の内の第3の色、すなわちブルーのドットパターンの反 転パターンで露光して静電潜像を形成する。電荷移動層 4を介してレッドとグリーンの陰極14をグラウンドに バイアスした場合、レッドとグリーンの陰極14上には 負電荷は帯電しないが、形成される静電潜像が、ブルー 40 着マスクと称する。 のドットパターンの反転パターンに対応することに変わ りはない。

【0038】次いで、図14に示すように、透明電極2 をグラウンド電位にパイアスし、一様帯電工程で電荷移 動層4を介してレッドとグリーンの陰極14をグラウン ドにバイアスした場合には、電荷移動層4を介してレッ ドとグリーンの陰極14を正電位にバイアスして、感光 性薄膜の露光部を、負電荷で帯電された粉体現像剤を用 いて現像する。その結果、図15に示すように、粉体現

形成する。この第3の密着マスク11は、負電荷に帯電 した粉体現像剤からなり、ブルーの発光ドット以外の部 分、すなわち、〔他2色分のドット幅〕+〔各色を互い 分離するスペース部〕に相当する領域を覆っている。従 って、第3の密着マスク11は、レッドの発光層12、 電子輸送層13及び画素電極すなわち陰極14とからな る3層積層体上と、グリーンの発光層12、電子輸送層 13及び画素電極すなわち陰極14とからなる3層積層 体上とを覆っており、且つ、レッドの発光層を形成する ために使用した第1の密着マスクの位置からも、グリー ンの発光層を形成するために使用した第2の密着マスク の位置からもずれた位置に形成されている。

【0039】その後、図15に示すように、透明電極2 を正電位にバイアスして、ブルーの発光層と電子輸送層 と画素電極層とを順番に一様に真空蒸着法により蒸着す る。蒸着後、静電潜像の電荷を利用して、第3の密着マ スクに用いた粉体現像剤を転写により取り去り、グリー ンの画素パターンの画素発光層と画素電極とを形成す る。かくして、図16に示すように、レッドの発光層と 電子輸送層と画素電極の3層積層体と、グリーンの発光 層と電子輸送層と画素電極の3層積層体と、ブルーの発 光層と電子輸送層と画素電極の3層積層体とが、互いに 分離されて、電荷移動層4の上に形成されている。

【0040】第4の態様

感光体電位と現像剤の帯電極性が逆極性の正現像法を使 用したカラー有機ELパネルの製造方法は、以下の通り である。上述したモノカラーの有機ELパネルの製造方 法の第2の態様により、レッド、グリーン、ブルー3色 中の第1の色、例えば、レッドの発光層12、電子輸送 層13及び画素電極すなわち陰極14とから3層積層体 を、電荷移動層4の上に形成した状態を、図17に示 す。前述の第2の態様と異なる点は、正現像の場合、所 望のレッドの発光ドットを露光して形成した静電潜像を 感光体帯電電荷の極性と逆極性の帯電極性現像剤を用い て現像して形成される分離隔壁は、レッドの発光ドット 以外の部分、すなわち、〔他2色分(すなわち、グリー ン、ブルー)のドット幅〕+〔各色を互い分離するスペ ース部〕に相当する領域を覆っていることであり、この ように形成された分離隔壁は、第3の態様と同様に、密

【0041】図17において、透明電極2をグラウンド 電位にバイアスして、更に好ましくは、レッドの陰極1 4を電荷移動層4を介してグラウンド電位にバイアスし て、レッドの発光層12、電子輸送層13及び画素電極 すなわち陰極14とから3層積層体を、電荷移動層4の 上に形成した感光性薄膜を一様帯電して、レッド、グリ ーン及びプルーの3色の内の第2の色、例えば、グリー ンのドッドパターンで露光して静電潜像を形成する。な お、図面において図面の簡略化のために、第4の態様で 像剤からなる分離隔壁すなわち第3の密着マスク11を 50 も、発光層12と電子輸送層13とを1つの有機層とし

て描いている。

【0042】次いで、図17に示すように、透明電極2 をグラウンドにパイアスし、レッドの陰極14を電荷移 動層4を介して負電位にパイアスして、感光性薄膜の非 露光部を、正電荷に帯電した粉体現像剤を用いて現像 し、図18に示すように、粉体現像剤からなる分離隔壁 すなわち第2の密着マスク11を形成する。この第2の 密着マスク11は、正電荷に帯電した粉体現像剤からな り、グリーンの発光ドット以外の部分、すなわち、〔他 2色分のドット幅〕+〔各色を互い分離するスペース 部)に相当する領域を覆っている。従って、第2の密着 マスク11は、レッドの発光層12、電子輸送層13及 び画素電極すなわち陰極14とから3層積層体上を覆っ ており、且つ、レッドの発光層を形成するために使用し た密着マスク(第1の密着マスクと称する)の位置から ずれた位置に形成されている。

15

【0043】その後、図18に示すように、透明電極2 を負電位にパイアスして、グリーンの発光層と電子輸送 層と画素電極層とを順番に一様に真空蒸着法により蒸着 マスクに用いた粉体現像剤を転写により取り去り、グリ ーンの画素パターンの画素発光層と画素電極とを形成す る。この状態で、図19に示すように、レッドの発光層 と電子輸送層と画素電極の3層積層体と、グリーンの発 光層と電子輸送層と画素電極の3層積層体とが電荷移動 層4の上に形成されている。

【0044】図19において、透明電極2をグラウンド 電位にパイアスして、更に好ましくは、レッドとグリー ンの陰極14を電荷移動層4を介してグラウンド電位に バイアスして、レッドの発光層と電子輸送層と画素電極 30 の3層積層体とグリーンの発光層と電子輸送層と画素電 極の3層積層体とが電荷移動層4の上に形成されている 感光性薄膜を一様帯電して、更に、レッド、グリーン及 びプルーの3色の内の第3の色、すなわちプルーのドッ トパターンのパターンで露光して静電潜像を形成する。 【0045】次いで、図19に示すように、透明電極2 をグラウンド電位にバイアスして、レッドとグリーンの 陰極14を電荷移動層4を介して負電位にパイアスし て、感光性薄膜の非露光部を、正電荷で帯電した粉体現 像剤を用いて現像し、図20に示すように、粉体現像剤 40 帯電電位V0は-400Vであった。 からなる分離隔壁すなわち第3の密着マスク11を形成 する。この第3の密着マスク11は、正電荷に帯電した 粉体現像剤からなり、ブルーの発光ドット以外の部分、 すなわち、〔他2色分のドット幅〕+〔各色を互い分離 するスペース部〕に相当する領域を覆っている。従っ て、第3の密着マスク11は、レッドの発光層12、電 子輸送層13及び画素電極すなわち陰極14とからなる 3層積層体上と、グリーンの発光層12、電子輸送層1 3及び画素電極すなわち陰極14とからなる3層積層体 上とを \mathcal{B} っており、且つ、レッドの発光層を形成するた 50 させた体積中心粒径 $6~\mu$ m、平均帯電量 $8~\mu$ C/gの球

めに使用した第1の密着マスクの位置からも、グリーン の発光層を形成するために使用した第2の密着マスクの 位置からもずれた位置に形成されている。

【0046】その後、図20に示すように、透明電極2 を負電位にパイアスして、ブルーの発光層と電子輸送層 と画素電極層とを順番に一様に真空蒸着法により蒸着す る。蒸着後、静電潜像の電荷を利用して、第3の密着マ スクに用いた粉体現像剤を転写により取り去り、グリー ンの画素パターンの画素発光層と画素電極とを形成す 10 る。かくして、図16に示すように、レッドの発光層と 電子輸送層と画素電極の3層積層体と、グリーンの発光 層と電子輸送層と画素電極の3層積層体と、ブルーの発 光層と電子輸送層と画素電極の3層積層体とが、互いに 分離されて、電荷移動層4の上に形成されている。な お、上述したプロセスは、任意に且つ微細領域に露光、 現像を行うことができるので、成膜順序は任意でよい。 [0047]

【実施例】実施例1

厚さ0.7mmのガラス基板に陽極としてスパッタによ する。蒸着後、静電潜像の電荷を利用して、第2の密着 20 りITO膜を20nmを形成し、リソグラフィーとウェ ットエッチングにより透明電極を形成した。シート抵抗 は、15Ω/ロで、配線幅300μm、スペース幅30 μmであった。その上に塗膜する電荷発生層(正孔注入 層)としてチタニルフタロシアニンとプチラール樹脂を 重量比で3.0:1となるよう秤量し、THF(テトラ ヒドロフラン)に溶かしミキサーで分散させ、固形分比 率3wt%の分散塗料を作製した。該塗料をディッピン グにより該ガラス基板の塗膜、乾燥し膜厚300nmの 薄膜を形成した。

> 【0048】電荷輸送層(正孔輸送層)として、N、 N'-ジフェニル-N, N'-ジ(3-メチルフェニ ル) -1, 1'ーピフェニル-4, 4'ージアミンとポ リカーポネートを重量比で2.5:1となるよう秤量 し、ジクロロメタンに溶かし固形分比率3wt%の分散 塗料を作製した。ジクロロメタンに溶かした塗液をディ ッピングにより膜厚300nmの薄膜を形成した。上記 のように有機感光体を形成した基板を、帯電ローラを用 いた接触式帯電器を用いて帯電させる。帯電ローラへの 印加電圧-700V、定電圧制御でガラス基板への表面

> 【0049】次に、半導体レーザーを用いて、ITOの 配線パターンに直交するように陰極間スペース部以外の 部分(所望の画素パターンの箇所)に対して選択的にパ ターン露光を行った。露光器の波長は、電荷発生剤の吸 収波長である780nmである。露光量は0.3mW/ cm'、露光スポット径は10μm、露光幅30μm で、露光電位Vi=-40Vの静電潜像を得た。次に、 現像剤として用いる現像剤には、スチレン-アクリル共 重合体の重合時に正帯電性帯電制御剤(CCA)を包含

形の重合現像剤を用いて、現像パイアスVb=-160 Vを現像剤担持体(ローラ)25に印加し現像を行い、 陰極間のスペース部(非露光部)に現像剤(分離壁)を 付けた。

【0050】その上に、グリーンの発光層として、ホス トにトリス(8-キノリノール)アルミニウム(アルミ キノリン錯体)、ドーパントとしてキナクリドン(ドー ピング濃度5wt%)を25nm共蒸着し、続いて電子 輸送層としてトリス (8-キノリノール) アルミニウム を30nm蒸着により形成した。次に、電極としてM g:Agを二源からの共蒸着により150nm蒸着し陰 極を形成した。

【0051】最後に、蒸着後の基板上に厚さ10μm程 度の無塵紙を配置し、転写ローラを用いて、転写パイア スVp =-400Vを印加し、分離壁に用いた現像剤を パネル基板から無塵紙に転写、除去することにより取り 去る。かくして、発光パターン形成、陰極分離を行い、 画素形成を行った。ドットピッチ300×300μm、 スペース30μm、画素数 256×64ドットのグリ ーンパネルが作製できた。

【0052】実施例2

厚さ1.1mmのガラス基板に陽極としてスパッタによ りITO膜を20nmを形成し、リソグラフィーとウェ ットエッチングにより透明電極を形成した。シート抵抗 は、15Ω/ロで、配線幅は160μm、スペース50 μmであった。電荷発生層(正孔注入層)として銅フタ ロシアニンとブチラール樹脂を重量比で3.0:1とな るよう秤量し、THFに溶かしミキサーで分散させ、固 形分比率5wt%の分散塗料を作製した。該塗料を、ガ ラス基板にITO薄膜を形成した基板上に、スピンコー 30 をホストに、ドーパントとして2, 9-ジメチルキナク トにより膜厚200nmの薄膜を形成した。

【0053】電荷輸送層(正孔輸送層)として、N、 N' -ジフェニル-N, N' -ピス $(\alpha -$ ナフチル) -1, 1'ーピフェニルー4, 4'ージアミンとポリカー ポネートを重量比で2.5:1となるよう秤量し、ジク ロロメタンに溶かし固形分比率2wt%の分散塗料を作 製した。該塗液をスピンコートによりガラス基板上に膜 厚300mmの薄膜を形成した。上記したように有機感 光体を形成した基板に、スコロトロンを用いて表面の帯 電電位 V0=-400 v に帯電させた。スコロトロンワ イヤ5aの印加電圧はDC約-3KV、定電流制御50 0 μA、グリッド5 b電圧 Vg=-400 Vである。

【0054】次に、反転現像を行うために、半導体レー ザーを用いてITOの配線パターンに直交するように、 所望の発光色パターン以外の箇所 (陰極間スペース部+ 所望の色以外の箇所に該当する部分)を選択的に露光を 行った。露光器の波長、露光量、露光スポット径は実施 例1と同様である。感光層表面の帯電電位V0=-40 0 V、露光電位Vi=-50 Vの静電潜像を形成した。

電子受容性物質を用いた帯電制御剤(CCA)を混練し たポリエステル樹脂を、体積中心粒径6µmまで粉砕、 平均帯電量=-11μC/gとし、現像バイアスVb= -150Vを印加して現像を行い、蒸着しようとする発 光部以外の基板部分 (露光部) に現像剤を付着させた。 その上に、レッドの発光層として、ホストとしてのトリ ス(8-キノリノール)アルミニウムにドーパントとし て4-ジシアノメチレン-2-メチル-6-(p-ジメ チルアミノスチリル) - 4 H - ピラン (D C M、ドーピ 10 ング濃度 5 w t %) を 2 5 n m 共蒸着、電子輸送層とし

18

てトリス(8-キノリノール)アルミニウム(アルミキ ノリン錯体)を35nm蒸着により形成した。次に、陰 極として、A1:Liを共蒸着により30nm、その後 アルミニウムのみを100nm蒸着した。

【0056】レッドパターンを作成後、基板上に厚さ1 0 μm程度の無塵紙を配置し、スコロトロンを用いて転 写パイアスVp = 400Vを印加して分離隔壁(現像剤 層) すなわち密着マスクを基板から除去した(図1

1)。スコロトロンワイヤ5aの印加電圧はDC約3K 20 V、定電流制御500μA、グリッド5b電圧 Vg=4 00Vである。

【0057】グリーン発光部形成についても同様に、帯 電、露光、現像、蒸着、転写工程を繰り返す。反転現像 では、先に形成したレッドの発光部は表面が陰極である ため、接地することにより帯電されず露光を行ったこと と同様となり現像される。更に、より現像効率を大きく するためには、陰極部に対して現像剤の極性とは逆極性 のバイアスを印加すればよい(図12)。グリーンの発 光部として、トリス(8-キノリノール)アルミニウム リドン(ドーピング濃度5wt%)を25nm共蒸着、 電子輸送層としてトリス(8-キノリノール)アルミニ ウムを35nm蒸着後、陰極として、Al:Liを共蒸 着により30nm、その後アルミニウムのみを100n m蒸着した(図13)。レッドの場合と同様に転写工程 により分離隔壁 (現像剤層) すなわち密着マスクを除去 した。

【0058】プルー発光部形成についても同様に、帯 電、露光、現像、蒸着、転写工程を繰り返す。ブルーの 40 発光部には、テトラフェニルプタジエンを25nm、レ ッド、グリーンと同様な材料、膜厚で電子輸送層、陰極 を蒸着により形成した(図15)。レッドの場合と同様 に転写工程により分離隔壁(現像剤層)すなわち密着マ スクを除去し、有機ELパネルを作製した。ドットピッ **チ50μm、スペース15μm、画素数 水平320×** 垂直240ドットのカラー表示可能なパネルが作製でき た(図16)。

【0059】実施例3

厚さ1.1mmのガラス基板に陽極としてスパッタによ 【0055】現像剤としてモノアゾ染料の金属錯体等の 50 りITO膜を20nmの膜厚に形成し、リソグラフィー

とウェットエッチングにより透明電極を形成した。シー ト抵抗は、15Ω/ロで、配線幅160μm、スペース 50 μmであった。電荷発生層(正孔注入層)として無 金属フタロシアニンとプチラール樹脂を重量比で3. 0:1となるよう秤量し、THFに溶かしミキサーで分 散させ、固形分比率5wt%の分散塗料を作製した。該 塗料を、ガラス基板に I T O薄膜を形成した基板上に、 スピンコートにより膜厚200nmの薄膜を形成した。 【0060】電荷輸送層(正孔輸送層)として、N、 N'-ジフェニル-N, N'-ピス (α-ナフチル) - 10 ルフェニル) -5- (4'-ピフェニル) 1, 3, 4-1, 1'-ピフェニルー4, 4'-ジアミンとポリカー ポネートを重量比で2.5:1となるよう秤量し、ジク ロロメタンに溶かし固形分比率2wt%の分散塗料を作 製した。該塗液をスピンコートによりガラス基板上に膜 厚300nmの薄膜を形成した。上記したように有機感 光体を形成した基板に、スコロトロンを用いて表面の帯 電電位 V0=-400 Vに帯電させた。スコロトロンワ イヤ5aの印加電圧はDC約-3KV、定電流500μ Aに制御し、グリッド5b電圧Vgは-400Vであ る。次に、半導体レーザーを用いてITOの配線パター 20 ンに直交するように、所望の画素パターンの箇所を選択 的に露光を行った(正現像)。露光器の波長、露光量、 露光スポット径は実施例1と同様である。感光層表面の 帯電電位 V0=-400 V、 露光電位 Vi=-40 Vの静 電潜像を形成した。

【0061】現像剤としてスチレン-アクリル共重合体 の重合時に正帯電性帯電制御剤(CCA)を包含させた 体積中心粒径 6 μm、平均帯電量 1 0 μ C / g の球形の 重合現像剤を用いて、現像パイアス Vb=-150 Vを 印加して現像を行い、蒸着しようとする発光部以外の基 30 板部分に現像剤を付着させた。

【0062】その上に、レッドの発光層としてトリス (8-キノリノール) アルミニウムにドーパントとして 4-ジシアノメチレン-2-メチル-6-(p-ジメチ ルアミノスチリル)-4H-ピラン(DCM、ドーピン グ濃度5wt%)を25nm共蒸着、電子輸送層として 2-(4'-t-プチルフェニル)-5-(4'-ピフ ェニル) 1, 3, 4-オキサジアゾールを35nm蒸着 により形成した。次に、Al:Liを共蒸着により30 nm、その後アルミニウムのみを100nm蒸着して陰 40 ノリン錯体30nmを蒸着した。 極を形成した。レッドパターンを作成後、基板上に厚さ 10μmのポリエチレン等の高分子シートを配置し、ス コロトロンを用いて転写パイアス Vp -300 Vを印加 して分離隔壁(現像剤層)すなわち密着マスクを基板か ら除去した(図11)。スコロトロンワイヤ5aの印加 電圧はDC約-2.7KV、定電流500μAに制御 し、グリッド5b電圧Vgは-300Vである。

【0063】グリーン発光部形成についても同様に、帯 電、露光、現像、蒸着、転写工程を繰り返す。正現像で は、現像に、有機感光体の表面電位(帯電電位)に対し 50

て逆極性の現像剤を用いるため、先に形成したレッド発 光部の陰極に対して、現像剤の極性とは逆極性のパイア スー250Vを印加する(図17)。これにより、レッ ド発光部上も現像され、マスクされた状態となる。すな わち、分離隔壁(現像剤層)すなわち密着マスクが形成 される。グリーンの発光部には、トリス(8-キノリノ ール) アルミニウム (A 1 q3) をホストに、ドーパン トとしてキナクリドン (ドーピング濃度3wt%)を2 5 n m 共蒸 着、 電子輸送 層として 2 - (4'-t-プチ オキサジアゾールを35nm蒸着後、陰極として、A 1:Liを共蒸着により30nm、その後アルミニウム のみを100nm蒸着した(図18)。レッドの場合と 同様に転写工程により分離隔壁(現像剤層)すなわち密 着マスクを除去した。

【0064】ブルー発光部形成についても同様に、帯 電、露光、現像、蒸着、転写工程を繰り返す。ブルーの 発光部には、ペンタフェニルシクロペンタジエンを25 nm蒸着し、レッド、グリーンと同様な材料、膜厚で電 子輸送層、陰極を蒸着により形成した。レッドの場合と 同様に転写工程により分離隔壁(現像剤層)すなわち密 着マスクを除去し、有機ELパネルを作製した。ドット ピッチ50μm、スペース15μm、画素数 水平32 0×垂直240ドットのカラー表示可能なパネルが作製 できた。

【0065】従来例

上記実施例と比較するために、厚さ1.1mmのガラス 基板に透明電極として膜厚120nm面抵抗15Ω/□ のIT〇薄膜をスパッタにより陽極を形成し、その上に 正孔注入、輸送層として、N,N'ージフェニルーN、 $N' - UZ (\alpha - TJFH) - 1, 1' - UJFH - UJFH$ 4, 4'ージアミンを50nm真空蒸着により形成し た。その上にレッド発光層材料として、トリス(8-キ ノリノール) アルミニウムにDCMを5w%ドーピング するように25nm共蒸着、グリーン発光層としてトリ ス(8-キノリノール)アルミニウムとドーパントとし てキナクリドンを3w%となるように25nm共蒸着、 ブルー発光層として、ペンタフェニルシクロペンタジエ ンを25nm蒸着し、続いて電子輸送層としてアルミキ

【0066】レッド、グリーン、ブルー各3色の色分離 には、メタルマスクをスライドさせて行った。次に、メ タルマスクを用いてITO、有機薄膜に直交するよう に、Al:Liを共蒸着により30nm、その後アルミ ニウムのみを120nm蒸菪して陰極を形成、有機EL パネルを作成した。上記マスクを用いた色分離方法で は、ドットピッチ80 μ m、スペース40 μ m以下はマ スクの位置合わせが困難で色ずれが発生し、パネル作成 は困難であった。

[0067]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 透明電極上に有機感光体を形成、選択的に露光、現像し 発光パターンを形成するので、従来の有機ELパネルの 製造方法において用いられている真空蒸着でマスクプレ ートをスライドさせる方法と比較して、マスクの歪みや 位置ずれによる材料の回り込み、分離不足が無くなり、 高い寸法精度、位置精度を確保できる。更に、発光パタ ーンの分解能は、露光器、現像剤の粒径に依存するの で、10μm程度まで微細加工ができる。また、成膜、 色分離プロセスが簡便で、スループットを上げることが 10 でき、不良率も改善できる。バインダーに正孔注入輸送 材料を分散させることにより、ITO-有機層界面の密 着性が上がり、材料の凝集、膜質変化が無くなる。これ により有機ELパネルの耐熱性が高くなり、長寿命化も はかれる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、透明基板上に透明電極と有機感光体薄 膜が形成された状態を示す断面図である。
- 【図2】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 20 造方法において、感光体薄膜を一様帯電させる第1の方 法を説明する断面図である。
- 【図3】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、感光体薄膜を一様帯電させる第2の方 法を説明する断面図である。
- 【図4】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、感光体薄膜を露光する態様を説明する 断面図である。
- 【図5】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、第1の態様での現像方法を説明する断 30 面図である。
- 【図6】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、第1の態様での発光層、電子輸送層、 陰極の積層体を形成する方法を説明する断面図である。
- 【図7】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、第1の態様での発光層、電子輸送層、 陰極の積層体を除去する方法を説明する断面図である。
- 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、第1の態様及び第2の態様で形成され る有機ELパネルの概略断面図である。
- 【図9】 本発明の実施例における有機ELパネルの製 造方法において、第2の態様での現像方法を説明する断 面図である。
- 【図10】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第2の態様での発光層、電子輸送 層、陰極の積層体を形成する方法を説明する断面図であ
- 【図11】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第2の態様での発光層、電子輸送 層、陰極の積層体を除去する方法を説明する断面図であ 50 13:電子輸送層

る。

- 【図12】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第3の態様での、第2の色のための 静電潜像の現像方法を説明する断面図である。
- 【図13】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第3の態様での、第2の色のための 発光層、電子輸送層、陰極の積層体を除去する方法を説 明する断面図である。
- 【図14】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第3の態様での、第3の色のための 静電潜像の現像方法を説明する断面図である。
- 【図15】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第3の態様での、第3の色のための 発光層、電子輸送層、陰極の積層体を除去する方法を説 明する断面図である。
- 【図16】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第3の態様及び第4の態様で形成さ れるカラー有機ELパネルの概略断面図である。
- 【図17】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第4の態様での、第2の色のための 静電潜像の現像方法を説明する断面図である。
- 【図18】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第4の態様での、第2の色のための 発光層、電子輸送層、陰極の積層体を除去する方法を説 明する断面図である。
- 【図19】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第4の態様での、第3の色のための 静電潜像の現像方法を説明する断面図である。
- 【図20】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造方法において、第4の態様での、第3の色のための 発光層、電子輸送層、陰極の積層体を除去する方法を説 明する断面図である。
- 【図21】 本発明の実施例における有機ELパネルの 製造に用いる現像器の断面図である。
- 【図22】 従来例の無機ELパネルの製造工程を説明 する断面図である。

【符号の説明】

1:透明基板

2:透明電極

40 3:電荷発生層(正孔注入層)

4:電荷移動層(正孔輸送層)

5:コロナ帯電器

6:接触式帯電器

7:表面電荷

8:露光器

9:静電潜像

10:現像剤

11:分離隔壁

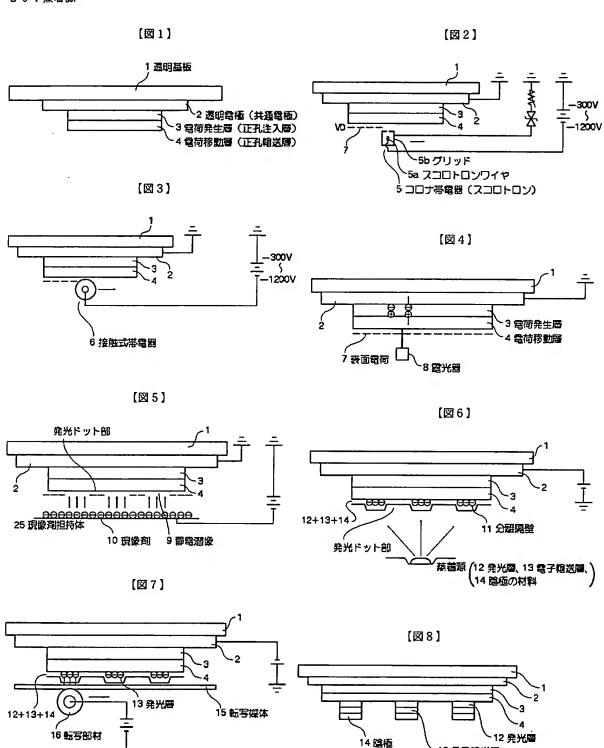
12:発光層

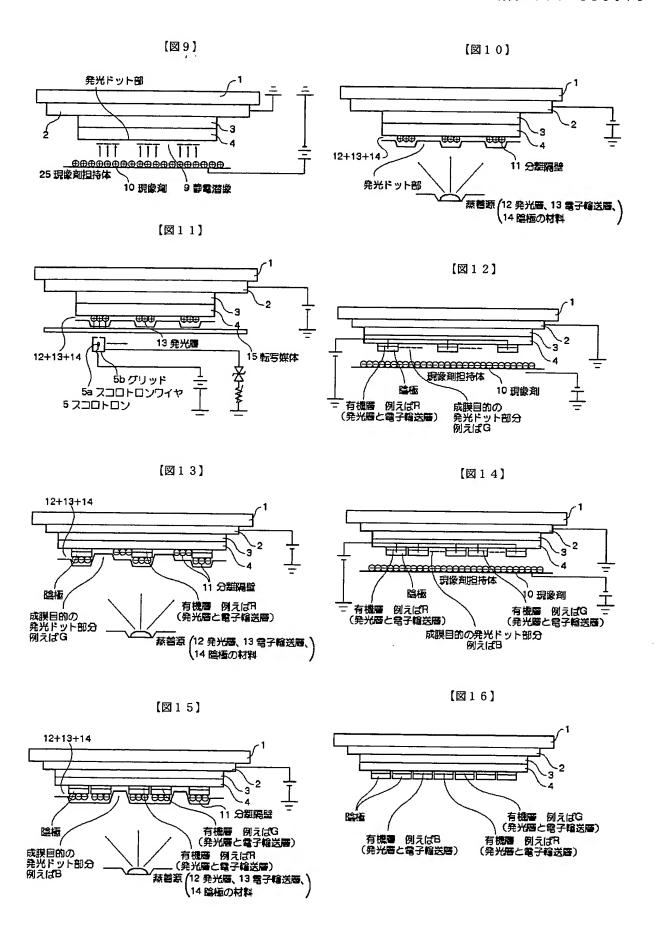
13 電子輸送層

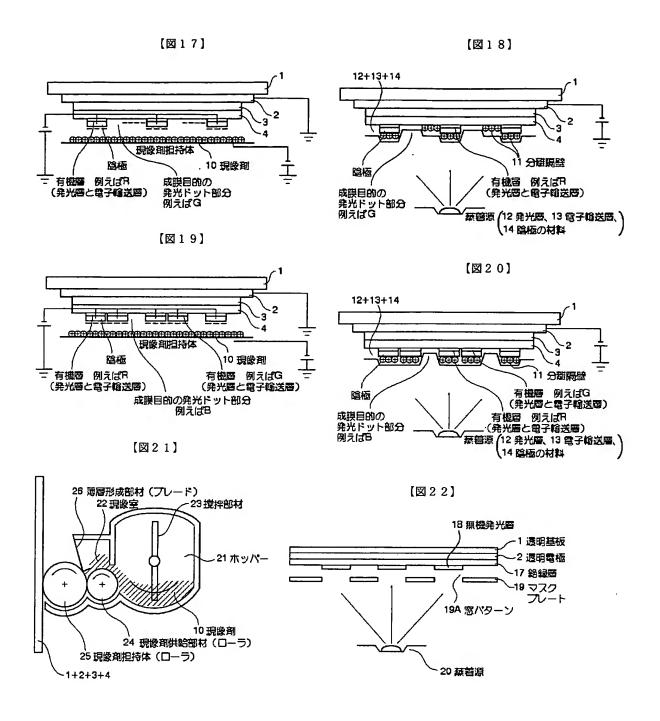


21:現像剤ホッパ 22:現像室 23:攪拌部材 24: 現像剤供給部材

25:現像剤担持体 26:薄層形成部材







【手続補正書】

【提出日】平成11年10月25日(1999.10.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項9

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項9】少なくとも一方が透明または半透明の対向 する一対の電極間に有機発光材料を積層した有機ELパ ネルであって、

透明または半透明の共通電極が一方の面に形成された透明基板と、

前記共通電極のほぼ全体を覆うように、前記共通電極上に<u>順次</u>形成された電荷発生層と電荷移動層と<u>からなり、</u> <u>酸光により静電潜像パターンが形成可能な、画案パター</u> ンに互いに分離されていない感光性薄膜と、

前記感光性薄膜上に、前記静電潜像パターンを利用した 転写除去により色ごとにパターン形成されて互いに分離 されている、発光層と電子輸送層と画素電極と<u>からなる</u> 多数の<u>積層体とを具備</u>していることを特徴とする有機E Lパネル。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

[0012]

【発明の実施の形態】以下に、図を用いて、本発明について説明する。まず、図1に示すように、ガラス等の透明基板1上に、酸化スズインジウム(ITO)、酸化スズ薄膜等の透明な共通電極2を形成する。なお、共通電極2は半透明でもよい。共通電極2を形成する薄膜形成

方法は、スパッタリング法、電子ビーム法、化学反応法等いずれを用いても良い。その透明な共通電極 2 上に、図 1 に示すように透明な共通電極 2 のほぼ全体を一様に覆うように、有機電荷発生層 3 と有機電荷移動層 4 からなる有機感光体層を形成する。有機電荷発生層 3 には、例えばブチラール樹脂に有機電荷発生剤を分散した塗液を用いて成膜する。有機電荷発生剤には、無金属フタロシアニンや銅フタロシアニンやチタニルフタロシアニンやパナジルフタロシアニンやチタニルフタロシアニンやパナジルフタロシアニン等のフタロシアニン化合物、ペリレン系色素、多環キノン系色素、スクアリリウム色素、アズレニウム色素等が使用できる。有機電荷発生層 3 は、少なくとも 0 、0 4 μ mの膜厚を有していることが好ましい。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)